

Germanium PNP Transistor

OD603/50

60V / 1A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1961

pnp-
Flächentransistor

OD 603/50

**Leistungstransistor mit
hoher Sperrspannung**

Gleichstrom-Meßwerte, $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

1. Arbeitspunkt $-U_{CE} = 1\text{ V}$, $-I_C = 100\text{ mA}$

Basisstrom	$-I_B$	3	mA
Basisspannung	$-U_{BE}$	370	mV

2. Arbeitspunkt $-U_{CE} = 1\text{ V}$, $-I_C = 500\text{ mA}$

Basisstrom	$-I_B$	20 < 32	mA
Basisspannung	$-U_{BE}$	700 < 1100	mV

Restströme

Collectorreststrom, $-U_{CB} = 6\text{ V}$ Emitter offen	$-I_{cbo}$	10 < 25	μA
Collectorreststrom, $-U_{Ck} = 6\text{ V}$ Emitter-Basis kurzgeschlossen	$-I_{ck}$	25 < 80	μA
Collectorreststrom, $-U_{CE} = 6\text{ V}$ Basis offen	$-I_{ceo}$	300 < 1000	μA

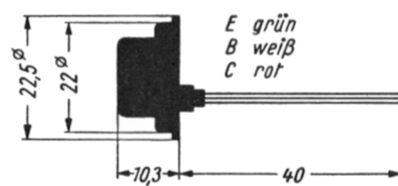
Wärme-Innenwiderstand

$R_{i\text{therm}}$	$\leq 7,5$	$^{\circ}\text{C/W}$
---------------------	------------	----------------------

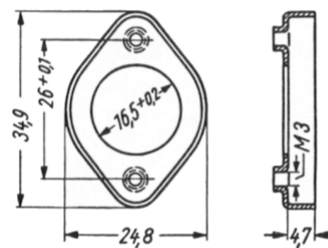
OD 603/50**Grenzwerte, absolute Maxima**

Spannung zwischen Collector und Emitter bei offener Basis	$-U_{CEo}$	50	V
Spannung zwischen Collector und Emitter bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke	$-U_{Ck}$	60	V
Spannung zwischen Collector und Basis bei offenem Emitter	$-U_{CBo}$	60	V
Spannung zwischen Emitter und Basis bei offenem Collector	$-U_{EBo}$	30	V
Collectorspitzenstrom, Impulsbreite < 1 ms, Impulsfolge 125 Hz	$-I_C$	1	A
Collector- + Emitter-Verlustleistung, $t_{\text{Gehäuse}} = 45^\circ\text{C}$	P_{C+E}	4	W
Sperrschichttemperatur	t_j	75	$^\circ\text{C}$

max. Abmessungen

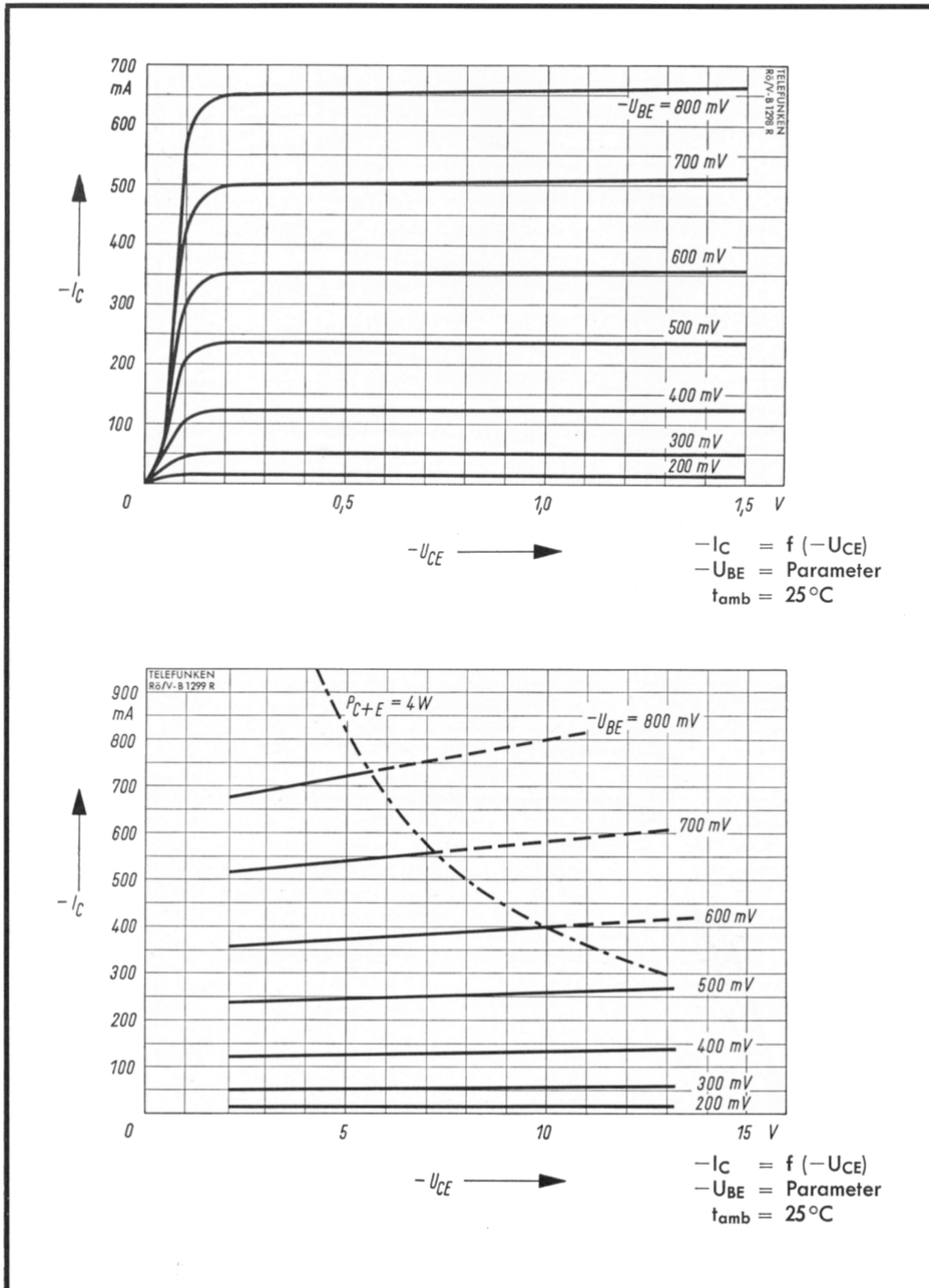


Gewicht: max. 12 g



Befestigungsflansch

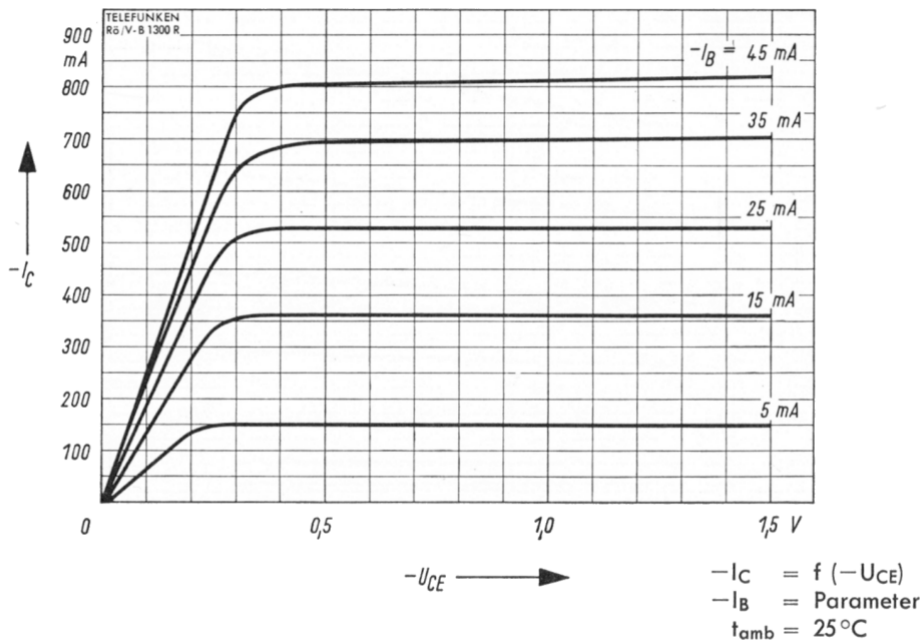
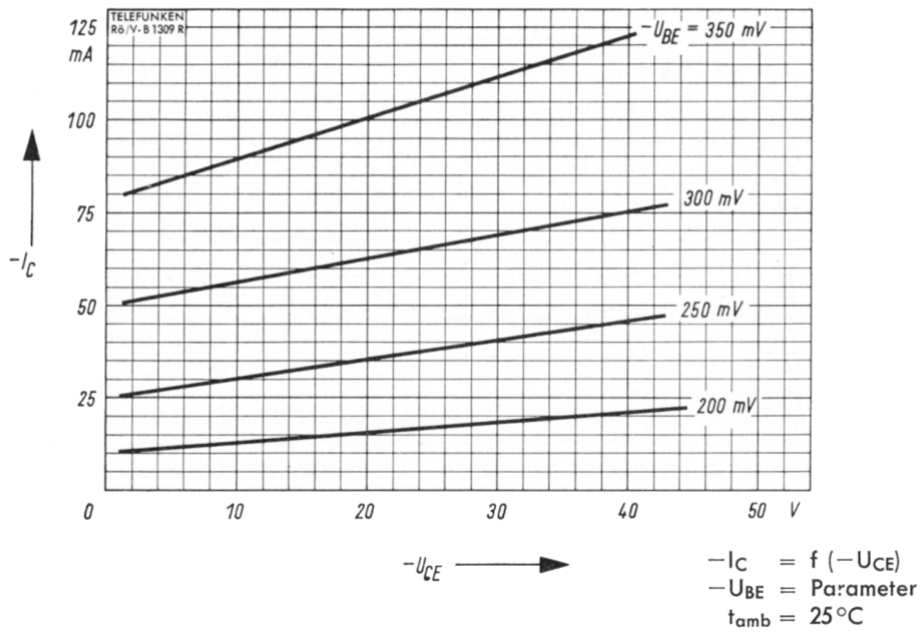
OD 603/50



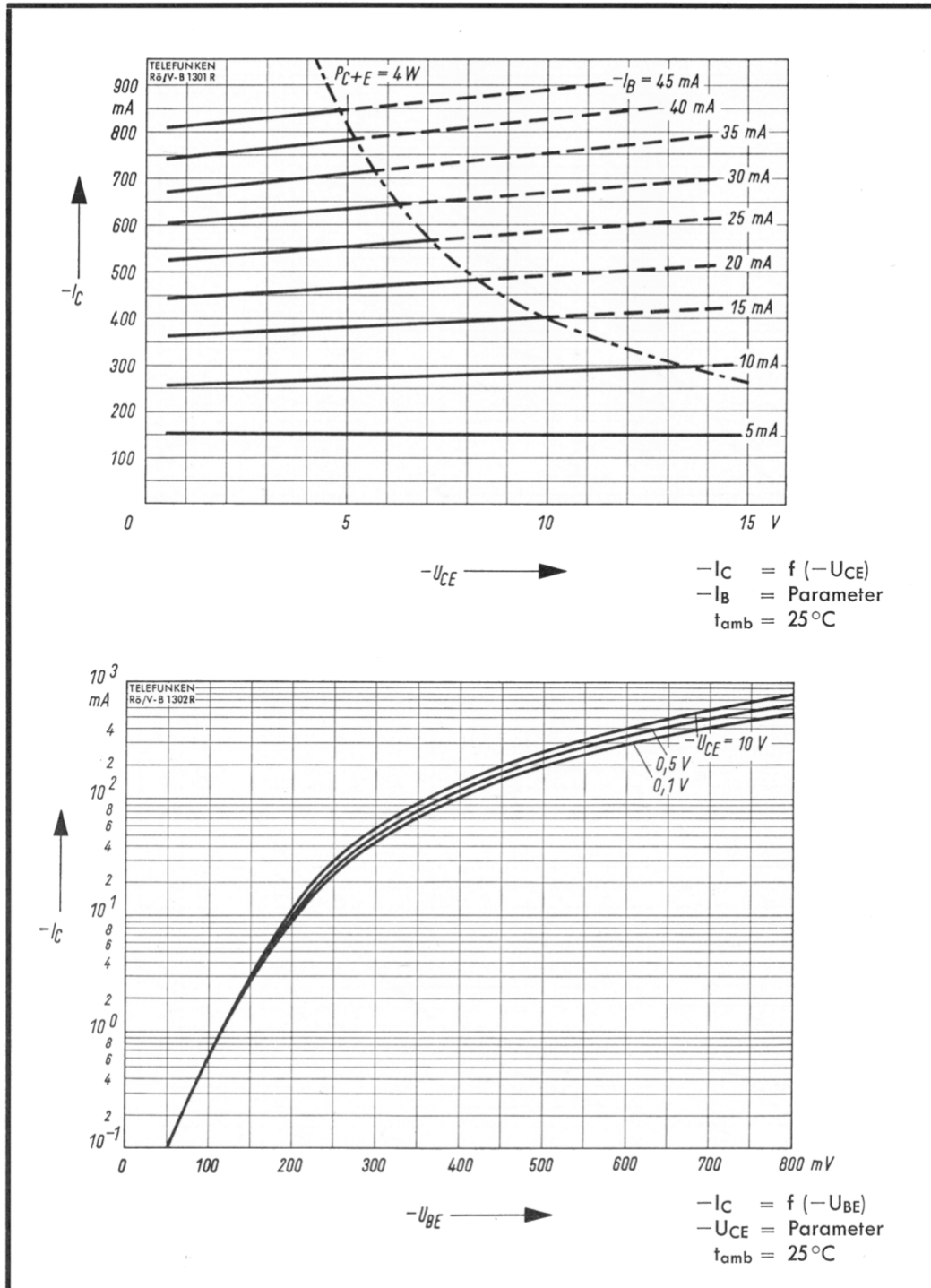
020161

135

OD 603/50



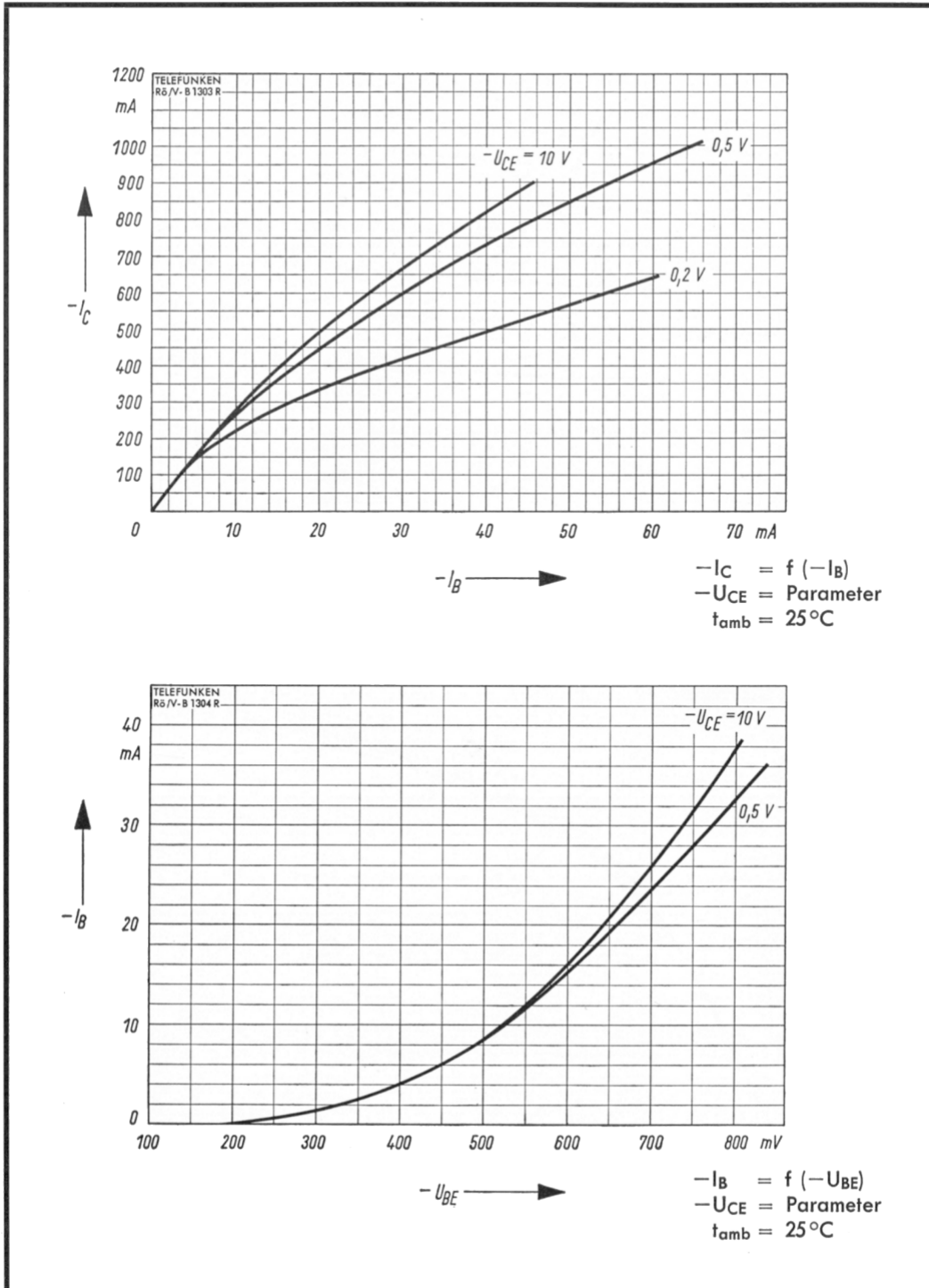
OD 603/50



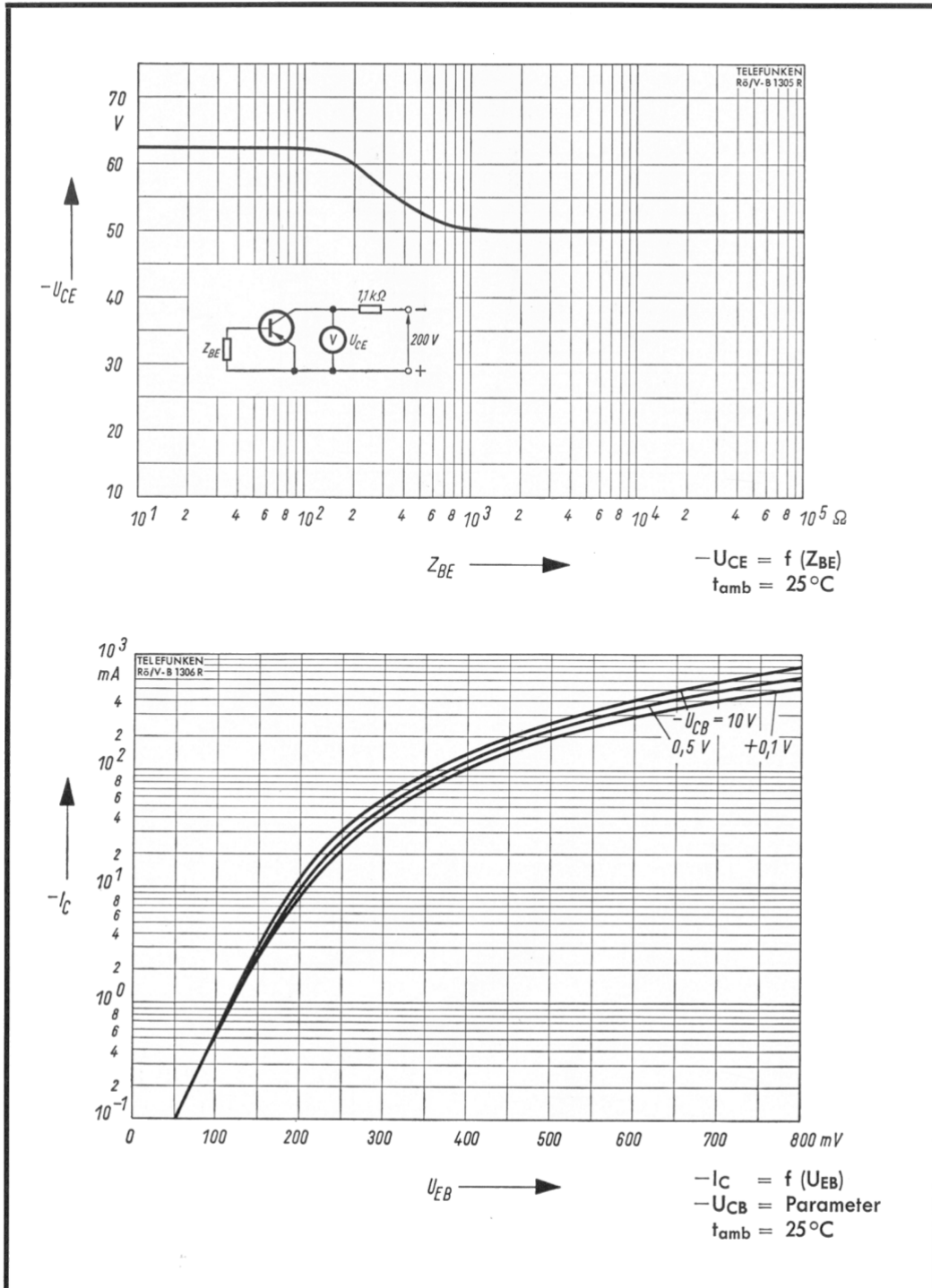
030161

137

OD 603/50



OD 603/50



040161

139

OD 603/50

